

## 文章内容

标题:	HFCVD法制备SiC薄膜工艺
作者:	赵武, 王雪文, 邓周虎, 张志勇
发表年限:	2002
发表期号:	3
单位:	(西北大学电子科学系, 陕西西安710069)
关键词:	低温生长; 碳化硅; 薄膜; 热丝CVD; 准晶
摘要:	分析研究了热丝化学汽相沉积(HFCVD)法工艺参数的变化对SiC薄膜质量的影响。结果表明, 合理的选取工艺参数, 可在较低温度(700~900°C)下, 沿Si(111)晶向异质生长出高质量的准晶SiC薄膜。  <a href="#">HFCVD法制备SiC薄膜工艺.pdf</a>

打印

关闭